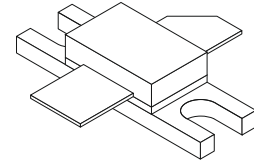


Мощный СВЧ GaN транзистор с напряжением питания 28 В
 Герметизирован в металлокерамическом корпусе КТ-55С-1
 Предназначен для работы в усилителях мощности до 4000 МГц



- Выходная мощность $P_{\text{вых}} = 50$ Вт
- Напряжение питания $U_{\text{си}} = 28$ В
- Коэффициент усиления по мощности $K_{\text{ур}} \geq 13,0$ дБ
- КПД стока $\eta_c \geq 50$ %

Предельно допустимые значения электрических режимов эксплуатации

Максимально допустимый постоянный ток стока	$I_{\text{с макс}}$	5,0	А
Максимально допустимый прямой ток затвора	$I_{\text{з (пр) макс}}$	12,0	мА
Максимально допустимое постоянное напряжение сток-исток	$U_{\text{си макс}}$	120	В
Напряжение затвор-исток	$U_{\text{зи}}$	-10 до +2	В
Максимально допустимая температура перехода	$t_{\text{п макс}}$	225	°С
Диапазон рабочих температур		-60 до +125	°С
Тепловое сопротивление переход-корпус транзистора	$R_{\text{т п-к}}$	2,5	°С/Вт

Электрические параметры транзисторов

Параметр	Обозначение	Режим измерения	Не менее	Тип.	Не более	Единица измерения	Температура среды (корпуса), °С
Остаточный ток стока	$I_{\text{с ост}}$	$U_{\text{си}}=80$ В; $U_{\text{зи}}=-8$ В	-	-	6,0	мА	25±10
Крутизна характеристики	S	$U_{\text{си}}=10$ В; $I_{\text{с}}=4,0$ А	3,9	4,3	-	А/В	25±10
Ток стока насыщения	$I_{\text{с нас}}$	$U_{\text{си}}=6$ В; $U_{\text{зи}}=2$ В	15,2	15,6	-	А	25±10
Выходная мощность	$P_{\text{вых}}$	$f=2900$ МГц; $U_{\text{си}}=28$ В $P_{\text{вх}}=2,5$ Вт $I_{\text{с}}=0,3$ А	50	55	-	Вт	(25±15)
Коэффициент усиления по мощности	$K_{\text{ур}}$	$f=2900$ МГц; $U_{\text{си}}=28$ В; $P_{\text{вых}}=50$ Вт $I_{\text{с}}=0,3$ А	13,0	13,2	-	дБ	(25±15)
КПД стока	η_c	$f=2900$ МГц; $U_{\text{си}}=28$ В; $P_{\text{вых}}=50$ Вт; $I_{\text{с}}=0,3$ А	50	55	-	%	(25±15)

Габаритный чертеж

